

Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam. Viện Khoa học vật liệu	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--	---

BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH: PHÓ GIÁO SƯ Mã hồ sơ:	ẢNH 4x6
---	---------

(Nội dung đúng ở ô nào thì đánh dấu vào ô đó: ; Nội dung không đúng thì để trống:)

Đối tượng đăng ký: Giảng viên ; Giảng viên thỉnh giảng

Ngành: Vật lý; Chuyên ngành: Quang học.

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên người đăng ký: Trần Quốc Tiến

2. Ngày tháng năm sinh: 27/7/1974. Nam ; Nữ ; Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: không

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam:

4. Quê quán: xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố: xã Hải Anh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định..

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 110 ngõ Văn Chương, phường Văn Chương, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội..

6. Địa chỉ liên hệ: P712, N021, Khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, tp. Hà Nội..

Điện thoại nhà riêng: 02436830660; Điện thoại di động: 0904762255;

Địa chỉ E-mail: tranquoctienims@gmail.com

7. Quá trình công tác:

– Từ năm 07/1996 đến năm 02/2003: Cán bộ nghiên cứu (Nghiên cứu viên), Viện Khoa học vật liệu, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, (Institute of Materials Science) 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu giấy, Hà Nội .

– Từ năm 06/2001 đến năm 09/2001: Thực tập sinh, Viện Khoa học Công nghệ Hàn Quốc, (Korean Institute of Science and Technology (KIST).) 5, Hwarang-ro 14-gil Seongbuk-gu, Seoul, 02792 Republic of Korea..

– Từ năm 02/2003 đến năm 05/2007: Nghiên cứu sinh, Viện Max-Born về quang phi tuyến & quang phổ xung ngắn Berlin, (Max Born Institute for Nonlinear Optics and Short Pulse Spectroscopy (MBI).) Max-Born-Straße 2A, 12489 Berlin, Germany..

– Từ năm 05/2007 đến năm 01/2010: Cộng tác viên nghiên cứu (sau Tiến sĩ), Viện Ferdinand-Braun về kỹ thuật tần số cao Berlin, (Ferdinand-Braun-Institut, Leibniz-Institut fuer Hochfrequenztechnik (FBH)) Gustav-Kirchhoff-Str. 4, 12489 Berlin, Germany..

– Từ năm 02/2010 đến năm 06/2019: Cán bộ nghiên cứu (Nghiên cứu viên chính), Trưởng phòng, Trợ lý Viện trưởng, Viện Khoa học vật liệu, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu giấy, Hà Nội.

Chức vụ: Hiện nay: Trưởng phòng, Trợ lý Viện trưởng; Chức vụ cao nhất đã qua: Trưởng phòng, Trợ lý Viện trưởng.

Cơ quan công tác hiện nay (khoa, phòng, ban; trường, viện; thuộc Bộ): Phòng Laser bán dẫn; Viện Khoa học vật liệu; Bộ Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam..

Địa chỉ cơ quan: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu giấy, Hà Nội .

Điện thoại cơ quan: 02437564129.

Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học;: Học viện KH&CN, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam.

8. Đã nghỉ hưu từ tháng năm

Nơi làm việc sau khi nghỉ hưu (nếu có):

Tên cơ sở giáo dục đại học nơi có hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối (tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ):

9. Học vị:

– Được cấp bằng ĐH ngày 27 tháng 05 năm 1996, ngành Vật lý, chuyên ngành: Vật lý chất rắn

Nơi cấp bằng ĐH (trường, nước): Trường Đại học Bách khoa Hà Nội/Số 1, Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội

– Được cấp bằng ThS ngày 08 tháng 01 năm 2001, ngành Vật lý, chuyên ngành: Quang học

Nơi cấp bằng ThS (trường, nước): Viện Vật lý, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam /10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội

– Được cấp bằng TS ngày 20 tháng 12 năm 2007, ngành Vật lý, chuyên ngành: Quang điện tử

Nơi cấp bằng TS (trường, nước): Trường Đại học Kỹ thuật Berlin/Strasse des 17. Juni 135 10623 Berlin, Germany

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS thời gian: Không có., ngành:

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo Sư tại HDGS cơ sở: Học viện Khoa học Công nghệ, Viện HLKH&CNVN:

Hội đồng II: Ngành Vật lý.

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo Sư tại HDGS ngành, liên ngành: Hội đồng ngành Vật lý.

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu:

- Vật liệu, linh kiện bán dẫn quang điện tử và ứng dụng
- Vật liệu, linh kiện quang tử và ứng dụng
- Linh kiện và thiết bị chiếu sáng

14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học:

- Đã hướng dẫn (số lượng) 0 NCS bảo vệ thành công luận án TS;

- Đã hướng dẫn (số lượng) 4 HVCH bảo vệ thành công luận văn ThS;

- Đã công bố (số lượng) 21 bài báo KH trong nước, 57 bài báo KH trên tạp chí có uy tín;

- Đã được cấp (số lượng) 1 bằng sáng chế, giải pháp hữu ích;

- Số lượng sách đã xuất bản 1, trong đó có 1 thuộc nhà xuất bản có uy tín.

Liệt kê không quá 5 công trình KH tiêu biểu nhất:

Bài báo khoa học tiêu biểu								
TT	Tên bài báo	Tên tác giả	Loại công bố (chỉ số IF)	Tên tạp chí, kỉ yếu khoa học	Tập	Số	Trang	Năm xuất bản
1	Mode transitions in Distributed Bragg Reflector semiconductor lasers: experiments, simulations and analysis	M. Radziunas, K.-H. Hasler, B. Sumpf, T. Q. Tien, H. Wenzel	SCI (KHTN-CN) (IF: 1.78)	Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics	44		105401	2011
2	Micro-External Cavity Tapered Lasers at 670 nm with 5 W peak power and nearly diffraction-limited beam quality (Tác giả chính)	T. Q. Tien, M. Maiwald, B. Sumpf, G. Erbert, and G. Tränkle	SCI (KHTN-CN) (IF: 3.77)	Optics Letters	33		2692	2008

3	Thermal properties and degradation behavior of red-emitting high-power diode lasers (Tác giả chính)	T. Q. Tien, F. Weik, J. W. Tomm, B. Sumpf, M. Zorn, U. Zeimer, and G. Erbert	SCI (KHTN-CN) (IF: 3.97)	Applied Physics Letters	88		181112	2006
4	Mechanical strain and defect distributions in GaAs-based diode lasers monitored during operation (Tác giả chính)	T. Q. Tien, J. W. Tomm, M. Oudart and J. Nagle	SCI (KHTN-CN) (IF: 3.89)	Applied Physics Letters	86		111908	2005

Bảng sáng chế tiêu biểu				
TT	Tên bằng sáng chế	Số tác giả	Tên cơ quan cấp	Ngày tháng năm cấp
1	Quy trình điều khiển thời điểm ra hoa của cây hoa cúc bằng hệ thống đèn điốt phát quang (Tác giả chính)	3	Cục sở hữu trí tuệ	10/05/2018

15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu):

– Chiến sĩ thi đua, cấp Viện Khoa học vật liệu.

16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, số quyết định và thời hạn hiệu lực của quyết định): Không có.

B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/ PHÓ GIÁO SƯ

1. Tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo (tự đánh giá):

Ứng viên đáp ứng yêu cầu về năng lực giảng dạy của nhà giáo, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy và đào tạo theo quy định hiện hành trong hơn 8 năm tham gia đào tạo ở bậc học đại học và sau đại học. Năng lực nghiên cứu tốt, tham gia đóng góp tích cực vào các hoạt động khoa học thuộc chuyên ngành. Đạo đức và lối sống lành mạnh; có tư tưởng tốt, lập trường vững vàng; trung thực và khách quan trong đào tạo và nghiên cứu khoa học

2. Thời gian tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên:

Tổng số 8 năm.

Khai cụ thể ít nhất 6 năm học, trong đó có 3 năm cuối tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ.

TT	Năm học	Hướng dẫn NCS		HD luận văn ThS	HD đồ án, khóa luận tốt nghệ nghiệp ĐH	Giảng dạy		Tổng số giờ giảng/số giờ quy đổi
		Chính	Phụ			ĐH	SĐH	
1	2011-2012	0	0	0	2	50	0	0/50
2	2012-2013	0	0	1	0	21	130	81,5/155,5
3	2013-2014	1	0	0	1	46	93	81,5/139,5
4	2014-2015	1	0	0	2	83	93	93/176
5	2015-2016	1	0	0	3	108	33	63/141
3 năm cuối								
1	2016-2017	1	0	0	1	55	93	90/148
2	2017-2018	1	0	1	1	58	103	33/161
3	2018-2019	1	0	2	4	130	173	30/303

3. Ngoại ngữ:

3.1. Ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Tiếng Anh

a) Được đào tạo ở nước ngoài :

– Học ĐH ; Tại nước: từ năm:

– Bảo vệ luận văn ThS hoặc luận án TS hoặc TSKH ; Tại nước: CHLB Đức năm: 2007

– Thực tập dài hạn (> 2 năm) ; Tại nước:

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước :

– Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: Trường Đại học Ngoại ngữ (Hà Nội); Số bằng: C 155 242; Năm cấp: 2001

c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài :

– Giảng dạy bằng ngoại ngữ:

– Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước):

d) Đối tượng khác ; Diễn giải:

3.2. Tiếng Anh giao tiếp (văn bằng, chứng chỉ): Bằng Đại học ngoại ngữ

4. Hướng dẫn thành công NCS làm luận án TS và học viên làm luận văn ThS (đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng):

TT	Họ tên NCS hoặc HV	Đối tượng		Trách nhiệm HD		Thời gian hướng dẫn từđến.....	Cơ sở đào tạo	Năm được cấp bằng/có quyết định cấp bằng
		NCS	HV	Chính	Phụ			
1	Đỗ Thị Thanh		✓	✓		04/2013 đến 12/2013	Trường ĐH Khoa học tự nhiên - ĐHQG Hà Nội	2013
2	Nguyễn Minh Tuấn		✓	✓		08/2017 đến 07/2018	Trường ĐH Khoa học - Đại học Thái Nguyên	2018
3	Nguyễn Mạnh Hiếu		✓	✓		11/2018 đến 05/2019	Trường ĐH Công nghệ - ĐHQG Hà Nội	2019
4	Vũ Hoàng		✓	✓		11/2018 đến 06/2019	Trường ĐH Công nghệ - ĐHQG Hà Nội	2019

5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo đại học và sau đại học:

*Giai đoạn Trước Tiến Sĩ Không có

*Giai đoạn Sau Tiến Sĩ

TT	Tên sách	Loại sách (CK, GT, TK, HD)	Nhà xuất bản và năm xuất bản	Số tác giả	Viết một mình hoặc chủ biên, phần biên soạn	Xác nhận của CSGDĐH (số văn bản xác nhận sử dụng sách)
1	Plasmonics	Sách chuyên khảo	IntechOpen, 2018	8	Viết chung	

- Trong đó, sách chuyên khảo xuất bản ở NXB uy tín trên thế giới sau khi được công nhận PGS (đối với ứng viên chức danh GS) hoặc cấp bằng TS (đối với ứng viên chức danh PGS):

6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu:

TT	Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ (CT, ĐT...)	CN/PCN/TK	Mã số và cấp quản lý	Thời gian thực hiện	Thời gian nghiệm thu (ngày, tháng, năm)
1	Nghiên cứu tính chất phổ của laser bán dẫn công suất cao GaAs ổn định bước sóng.	Chủ nhiệm	103.06-2010.18, Nhà nước	12/2010 đến 12/2012	29/03/2013
2	Nghiên cứu thiết kế chế tạo các hệ thiết bị LED công suất cao cho ứng dụng nghiên cứu thử nghiệm quá trình chiếu sáng điều khiển ra hoa của cây hoa cúc	Chủ nhiệm	CSCL04.13, Cơ sở	01/2013 đến 12/2013	27/01/2014
3	Nghiên cứu, xây dựng hệ giao thoa hai chùm tia sử dụng trong nghiên cứu và chế tạo các cấu trúc quang tử trên vật liệu polyme	Chủ nhiệm	HTTD02-2016, Cơ sở	01/2016 đến 12/2016	01/03/2017

7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, sáng chế/giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc

gia/quốc tế):

7.1. Bài báo khoa học đã công bố:

*Giai đoạn Trước Tiến Sĩ

TT	Tên bài báo	Số tác giả	Tên tạp chí hoặc kỹ yếu khoa học	Tạp chí quốc tế uy tín (và IF) (*)	Số trích dẫn của bài báo	Tạp/Số	Trang	Năm công bố
1	Nghiên cứu cấu trúc phổ và một số đặc trưng khác của laser bán dẫn công suất cao dạng thanh được packaging tại Việt nam	6	Advances in Optics, Photonics, Spectroscopy and Applications IV			IV/	261-266	2007
2	Optical techniques for investigation of defects in high power laser diodes (Tác giả chính)	2	Advances in Optics, Photonics, Spectroscopy and Applications IV			IV/	291-297	2007
3	Gradual degradation of red-emitting high power diode laser bars	8	Applied Physics Letters	SCI (KHTN-CN) (IF: 3.68)		90/	171113	2007
4	Processing-induced strain at solder interfaces in extended semiconductor structures	4	Journal of Applied Physics	SCI (KHTN-CN) (IF: 2.21)		101/	114512	2007
5	Packaging of the optical modules used for fiber optic communications	6	Proceedings of International Workshop on Photonic Opportunities and Networking Event			/	80-84	2007
6	Degradation behavior and thermal properties of red (650 nm) high-power diode single emitters and laser bars	8	Proc. SPIE 6456	Scopus (KHTN-CN)	6	6456/	645606	2007

7	Spectroscopic strain measurement methodology: Degree-of-polarization photoluminescence vs. photocurrent spectroscopy	3	Applied Physics Letters	SCI (KHTN-CN) (IF: 3.97)		88/	133504	2006
8	Strain relaxation and defect creation in diode laser bars	5	Materials Science in Semiconductor Processing	SCI (KHTN-CN) (IF: 1.12)	2	9/	215-219	2006
9	Observation of deep level defects within the waveguide of red-emitting high-power diode lasers	10	Applied Physics Letters	SCI (KHTN-CN) (IF: 3.97)	18	88/	133513	2006
10	Spatially-resolved and temperature-dependent thermal tuning rates of high-power diode laser arrays	8	Applied Physics Letters	SCI (KHTN-CN) (IF: 3.97)		88/	133510	2006
11	Thermal properties and degradation behavior of red-emitting high-power diode lasers (Tác giả chính)	7	Applied Physics Letters	SCI (KHTN-CN) (IF: 3.97)	20	88/	181112	2006
12	Carrier transport and recombination in resonantly excited InGaAs/ GaAs MQWs	7	28th International Conference on Physics of Semiconductors, Vienna			28/		2006
13	Some results on optical module packaging and characterization	6	Advances in Photonics and Applications			/	141-145	2005
14	Relaxation of packaging-induced strains in AlGaAs-based high-power diode laser arrays (Tác giả chính)	9	Applied Physics Letters	SCI (KHTN-CN) (IF: 3.89)	8	86/	101911	2005

15	Mechanical strain and defect distributions in GaAs-based diode lasers monitored during operation (Tác giả chính)	4	Applied Physics Letters	SCI (KHTN-CN) (IF: 3.89)	11	86/	111908	2005
16	Electronic structure and optoelectronic properties of strained InAsSb/GaSb multi quantum-well	8	Applied Physics Letters	SCI (KHTN-CN) (IF: 3.89)	2	87/	181911	2005
17	Screening of high-power diode laser bars by optical scanning (Tác giả chính)	9	Applied Physics Letters	SCI (KHTN-CN) (IF: 3.89)	6	87/	211110	2005
18	Spectroscopic analysis of external stresses in semiconductor quantum-well materials	6	Materials Research Society Symposium - Proceedings			829/	233-242	2005
19	Aging properties of High-Power Diode Laser Bars: Relaxation of Packaging-Induced Strains and Corresponding Defect Creation Scenarios	4	2005 CLEO®/Europe-EQEC Conference, Munich, Germany			/	CB6-1-WED http://ieeexplore.ieee.org/document/1567900	2005
20	MOVPE growth of semiconductor disk laser (SCDL) structures	8	Proc. 11th European Workshop on Metalorganic Vapour Phase Epitaxy, Lausanne, Switzerland			11/	309-311	2005
21	Transient thermal tuning properties of single emitters in actively cooled high-power cm-bar arrays	7	Proc. SPIE 5336	Scopus (KHTN-CN)	6	5338/	125-131	2004
22	Device deformation during low-frequency pulsed operation of high-power diode bars	9	Applied Physics Letters	SCI (KHTN-CN) (IF: 3.91)	21	84/	3525-3527	2004

23	Industrial MQW laser diodes used for optical module preparation	3	Proc. of the 8th Vietnam Conference on Radio & Electronics (REV'02)			/	233-237	2003
24	Nghiên cứu công nghệ chế tạo một số loại module laser đơn mode dung cho truyền thông quang	4	Tạp chí bưu chính viễn thông: số chuyên san			/	51-57	2003
25	Optoelectronic behaviors of Transmitter modules based on Quantum-well Laser diodes	3	Physics & Engineering in Evolution (Proc. of the Fifth Vietnamese-German Seminar on Physics & Engineering (GVSS5))			/	308-311	2002
26	Influence of the Antireflection coating on Properties of the 1310 InGaAsP/InP Laser Diode Cavity	5	Proceeding of the Third National Conference on Optics and Spectroscopy			/		2002
27	Spectral structure of single mode laser module based on 1310nm Multi Quantum well InGaAsP/InP laser diode chip (Tác giả chính)	3	Proceeding of the Third National Conference on Optics and Spectroscopy			/		2002
28	Noise properties in single mode optical laser module based on multi quantum well 1310nm InGaAsP/InP laser diodes	3	Proceeding of the Third National Conference on Optics and Spectroscopy			/		2002
29	Optical switch based on the optoelectronic effect of laser transmitter modules working in wavelength region 830 nm and 1310 nm	5	Advances in Optics and Spectroscopy			/	428-431	2001

30	Single model optical laser transmitter and receiver modules used for fiber optic communication	5	Advances in Optics and Spectroscop			/	432-435	2001
31	Single mode transmitter modules based on InGaAsP/InP laser diode chips and their negative optoelectronic effect	5	Extended Abstract of the Fourth German-Vietnamese Seminar on Physics & Engineering (GVS4)			/	160-163	2001
32	Hiệu ứng quang điện âm trong laser bán dẫn: cơ chế vật lý và khả năng ứng dụng	6	Tuyển tập Báo cáo tại Hội nghị Vật lý toàn quốc lần thứ V - Hà Nội			/	1002-1006	2001
33	Quá trình già hóa trong module phát quang học trên cơ sở diode laser bán dẫn	4	Những vấn đề hiện đại của Quang học & Quang phổ - Tập II			2/	368-374	2000
34	Kỹ thuật truyền hình ảnh và âm thanh đồng thời qua một sợi cáp quang sử dụng module thu, phát quang học	6	Những vấn đề hiện đại của Quang học & Quang phổ - Tập II			2/	611-616	2000
35	Degradation study of the laser transmitter modules used for optical fiber transmission systems	4	Trends in Materials Science and Technology – Part II	Khác		2/	681-684	1999
36	Negative optoelectronic phenomenon in laser transmitter modules used for optical fiber communication systems	5	Trends in Materials Science and Technology – Part II	Khác		2/	685-688	1999
37	Bước đầu ứng dụng laser vào châm cứu ở Việt Nam	13	Những vấn đề hiện đại của Quang học & Quang phổ - Tập I	Khác		1/	501-505	1996

*Giai đoạn Sau Tiến Sĩ

TT	Tên bài báo	Số tác giả	Tên tạp chí hoặc kỹ yếu khoa học	Tạp chí quốc tế uy tín (và IF) (*)	Số trích dẫn của bài báo	Tập/Số	Trang	Năm công bố
38	Nghiên cứu phát triển hệ tản nhiệt trên cơ sở heat pipe ứng dụng cho đèn LED công suất cao đến 300W (Tác giả chính)	5	Advances in Applied and Engineering Physics V; ISBN: 978-604-913-232-2			V/	101-106	2018
39	Nghiên cứu nâng cao chất lượng phổ của laser bán dẫn taper công suất cao vùng 670 nm bằng cách tử phản xạ Bragg (Tác giả chính)	2	Advances in Applied and Engineering Physics V; ISBN: 978-604-913-232-2			V/	132-138	2018
40	Influence of coupling coefficient on spectral linewidth of DFB high-power diode laser at 780 nm using in atomic absorption (Tác giả chính)	2	Advances in Applied and Engineering Physics V; ISBN: 978-604-913-232-2			V/	383-387	2018
41	Spectral linewidth versus resonator length in high power DFB diode laser (Tác giả chính)	2	Advances in Applied and Engineering Physics V; ISBN: 978-604-913-232-2			V/	388-392	2018
42	Spectral Linewidth vs. Front Facet Reflectivity of 780 nm DFB Diode Lasers at High Optical Output Power	9	Applied Sciences	SCIE (KHTN-CN) (IF: 2.217)		8/	1104	2018
43	ns-MOPA-dual wavelength at 965 nm with 16 W peak power suitable for water vapor detection	6	Advances in Optics, Photonics, Spectroscopy and Applications IX; ISBN: 978-604-913-578-1			IX/	136-142	2017

44	Light distributor design for natural light illumination system	5	Advances in Optics, Photonics, Spectroscopy and Applications IX; ISBN: 978-604-913-578-1			IX/	143-146	2017
45	Large area photonic crystals fabricated by interference technique	7	Advances in Optics, Photonics, Spectroscopy and Applications IX; ISBN: 978-604-913-578-1			IX/	455-459	2017
46	Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị laser bán dẫn sợi quang đa bước sóng tách tay ứng dụng trong quang trị liệu và phục hồi chức năng (Tác giả chính)	5	Advances in Optics, Photonics, Spectroscopy and Applications IX; ISBN: 978-604-913-578-1			IX/	485-490	2017
47	Simulation and experiment results of high-power DFB diode laser linewidth power product at 780 nm	5	2017 European Conference on Lasers and Electro-Optics & European Quantum Electronics Conference			/	151	2017
48	Applications of LEDs in agriculture fishing and insect trapping	7	Advances in Applied and Engineering Physics IV; ISBN: 978-604-913-232-2			IV/	11-19	2016
49	Optical fiber daylighting system base on non-imaging optics	3	Advances in Applied and Engineering Physics IV; ISBN: 978-604-913-232-2			IV/	20-25	2016
50	Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ bức xạ từ đèn LED trong kỹ thuật chiếu sáng phá đêm cho cây hoa cúc (Tác giả chính)	4	Advances in Applied and Engineering Physics IV; ISBN: 978-604-913-232-2			IV/	354-359	2016
51	Nghiên cứu thiết kế chế tạo thử nghiệm hệ đèn LED công suất cao điều khiển ra hoa cho cây hoa cúc (Tác giả chính)	8	Advances in Applied and Engineering Physics IV; ISBN: 978-604-913-232-2			IV/	360-365	2016

52	Thiết kế chế tạo thiết bị LED công suất cao điều biến quang ứng dụng trong thẩm mỹ và vật lý trị liệu (Tác giả chính)	4	Advances in Applied and Engineering Physics IV; ISBN: 978-604-913-232-2			IV/	438-443	2016
53	Interplay between and defect in high power diode laser (Tác giả chính)	3	Advances in Optics, Photonics, Spectroscopy and Applications VIII; ISSN 1859 - 4271			VIII/	61-66	2015
54	Microwave photonic system applied to refractive index measurement	6	Advances in Optics, Photonics, Spectroscopy and Applications VII; ISSN 1859 - 4271			VIII/	100-106	2015
55	Determination of high power DFB diode laser parameters base on amplified spontaneous emission spectrum	2	Advances in Optics, Photonics, Spectroscopy and Applications VIII; ISSN 1859 - 4271			VIII/	351-356	2015
56	Ứng dụng thử nghiệm thiết bị trị liệu laser diode trong chữa bỏng và vết thương thực nghiệm trên thỏ	6	Advances in Optics, Photonics, Spectroscopy and Applications VIII; ISSN 1859 - 4271			VIII/	657-661	2015
57	Dependence of DFB laser linewidth on optical output power: study case of 780 nm high-power RW-DFB diode lasers	2	Advances in Optics, Photonics, Spectroscopy and Applications VII; ISSN 1859 - 4271			VII/	65-70	2013
58	Fiber-coupled 670 nm and 940 nm high-power diode laser modules for medical applications	5	Advances in Optics, Photonics, Spectroscopy and Applications VII; ISSN 1859 - 4271			VII/	425-429	2013

59	Electro-Optical characterization of high-power distributed feedback diode lasers for high resolution rubidium spectroscopy	2	Advances in Optics, Photonics, Spectroscopy and Applications VII; ISSN 1859 - 4271			VII/	801-806	2013
60	Measurement of junction temperature of high power laser diodes and light-emitting diodes	4	Advances in Optics, Photonics, Spectroscopy and Applications VII; ISSN 1859 - 4271			VII/	807-811	2013
61	Preparation of the high power laser diode equipment working in the red and IR spectral regions for therapy	6	Advances in Optics, Photonics, Spectroscopy and Applications VII; ISSN 1859 - 4271			VII/	893-897	2013
62	Influence of resonator parameters and thermal effect on optical spectra of integrated grating high power diode lasers	2	Advances in Optics, Photonics, Spectroscopy and Applications VII; ISSN 1859 - 4271			VII/	904-909	2013
63	Module laser công suất cao và ứng dụng	7	Tạp chí Khoa học công nghệ (Viện HL Khoa học & Công nghệ VN); ISSN : 0866 708X			51/2A	47-59	2013
64	Preparation and characterization of fiber-coupled 670 nm and 940 nm high power laser diode modules	5	Book of papers of 9th Belarusian–Russian Workshop on "Semiconductor Lasers and Systems"			/	146-149	2013
65	High power laser diode equipment working in the red and IR spectral regions for therapy modules	5	Book of papers of 9th Belarusian–Russian Workshop on "Semiconductor Lasers and Systems"			/	195-198	2013

66	Structural properties of mixed magnetic oxide determined from synchrotron powder diffraction	4	The 7th Asia Ocenia Forum for Synchrotron Radiation Research			/	88	2013
67	Design and fabrication of side-channel photonic crystal fiber	9	Photonics Global Conference (PGC) 2012			1/	http://ieeexplore.ieee.org/document/6458004	2012
68	Nghiên cứu thiết kế chế tạo và khảo sát các thông số cơ bản của module laser công suất cao phát ở vùng sóng 670 & 940 nm sử dụng cho nghiên cứu điều trị bỏng viêm nhiễm và các bệnh về xương khớp. (Tác giả chính)	4	Tạp chí Y dược lâm sàng 108; ISBN: 1859-2872			7/	143-148	2012
69	An optical heterodyne technique for characterization of high power DFB diode lasers with ultra-narrow spectral linewidth	5	Advances in Optics, Photonics, Spectroscopy and Applications VI; ISSN 1859 - 4271			VI/	117-122	2011
70	Strain measurement in High-power diode laser by photocurrent spectroscopy (Tác giả chính)	2	Advances in Optics, Photonics, Spectroscopy and Applications VI; ISSN 1859 - 4271			VI/	123-129	2011
71	Investigation of excitation laser module for raman spectroscopy based on high power DFB 780 nm diode lasers	9	Advances in Optics, Photonics, Spectroscopy and Applications VI; ISSN 1859 - 4271			VI/	154-160	2011
72	Optical laser diode module preparation and characterization	9	Advances in Optics, Photonics, Spectroscopy and Applications VI; ISSN 1859 - 4271			VI/	416-421	2011

73	Mode transitions in Distributed Bragg Reflector semiconductor lasers: experiments, simulations and analysis	5	Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics	SCI (KHTN-CN) (IF: 1.78)	25	44/	105401	2011
74	Phương pháp chặn mode bậc cao trong sợi quang có cấu trúc micro sử dụng trong công nghệ FTTH	4	Chuyên san Tạp chí Bru chính Viễn thông,			Kỳ 3 -Tập V-1/	1	2011
75	Preparation of 980nm tapered diode laser module for investigating upconversion luminescenc	7	Proc. of the 2nd Academic conference on Natural Science for Master & PhD students from Cambodia-Laos-Malaysia-Vietnam			/	285-289	2011
76	Laser công suất cao, một số ứng dụng và mô phỏng động quá trình truyền năng lượng không dây bằng tia laser từ điểm đến điểm	3	Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Công nghệ vũ trụ và ứng dụng”			/	253-263	2010
77	Micro-External Cavity Tapered Lasers at 670 nm with 5 W peak power and nearly diffraction-limited beam quality (Tác giả chính)	5	Optics Letters	SCI (KHTN-CN) (IF: 3.77)	17	33/	2692	2008
78	Screening of high power laser diode bars in terms of stresses and thermal profiles	12	Proc. SPIE 6876	Scopus (KHTN-CN) (IF: 0.38)	4	6876/	687619	2008

- Trong đó, bài báo đăng trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín sau khi được công nhận PGS hoặc cấp bằng TS:

Chú thích: (*) gồm SCI, SCIE, ISI, Scopus (KHTN-CN); SSCI, A&HCI, ISI và Scopus (KHXXH-NV); SCI nằm trong SCIE; SCIE nằm trong ISI; SSCI và A&HCI nằm trong ISI.

7.2. Bảng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích:

*Giai đoạn Trước Tiến Sĩ Không có.

*Giai đoạn Sau Tiến Sĩ

TT	Tên bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích	Tên cơ quan cấp	Ngày tháng năm cấp	Số tác giả
1	Quy trình điều khiển thời điểm ra hoa của cây hoa cúc bằng hệ thống đèn điốt phát quang (Tác giả chính)	Cục sở hữu trí tuệ	10/05/2018	3

- Trong đó, bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích cấp sau khi được công nhận PGS hoặc cấp bằng TS:

7.3. Giải thưởng quốc gia, quốc tế (Tên giải thưởng, quyết định trao giải thưởng,...):

*Giai đoạn Trước Tiến Sĩ

Không có.

*Giai đoạn Sau Tiến Sĩ

Không có.

- Trong đó, giải thưởng quốc gia, quốc tế sau khi được công nhận PGS hoặc cấp bằng TS:

8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương trình nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học:

Không có.

9. Các tiêu chuẩn còn thiếu so với quy định cần được thay thế bằng bài báo khoa học quốc tế uy tín:

- Thời gian được cấp bằng TS, được bổ nhiệm PGS:

- Giờ chuẩn giảng dạy:

- Công trình khoa học đã công bố:

- Chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ:

- Hướng dẫn NCS, ThS:

C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH:

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

..., ngày..... tháng..... năm 201...

Người đăng ký

(Ghi rõ họ tên, ký tên)

D. XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN NƠI ĐANG LÀM VIỆC

– Về những nội dung "Thông tin cá nhân" ứng viên đã kê khai.

– Về giai đoạn ứng viên công tác tại đơn vị và mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn này.

(Những nội dung khác đã kê khai, ứng viên tự chịu trách nhiệm trước pháp luật).

..., ngày.....tháng.....năm 201...

Thủ trưởng cơ quan

(Ghi rõ họ tên, ký tên, đóng dấu)